

СОДЕРЖАНИЕ

Том 48, номер 3, 2019

МОДЕЛИРОВАНИЕ

- Модель на языке Verilog-A многоуровневого биполярного мемристора с учетом девиаций параметров переключения
Г. С. Теплов, Е. С. Горнев 163
- Логический С-элемент на основе STG DICE триггера для асинхронных цифровых устройств, устойчивых к воздействиям одиночных ядерных частиц
Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин 176
- Моделирование методом Монте-Карло дефектов профиля тренча в процессе глубокого криогенного травления кремния
М. К. Руденко, А. В. Мяконьких, В. Ф. Лукичев 191
-

ИЗБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ “ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ” ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

- Методы и алгоритмы для логико-топологического проектирования микроэлектронных схем на вентиляльном и межвентильном уровне для перспективных технологий с вертикальным затвором транзистора
Г. А. Иванова, Д. И. Рыжова, С. В. Гаврилов, Н. О. Васильев, А. Л. Стемпковский 201
- Маршрут топологического синтеза для реконфигурируемых систем на кристалле специального назначения
С. В. Гаврилов, Д. А. Железников, М. А. Заплетина, В. М. Хватов, Р. Ж. Чочаев, В. И. Эннс 211
- Извлечение сети логических элементов из КМОП-схемы транзисторного уровня
Д. И. Черемисинов, Л. Д. Черемисинова - 224
-

ЛИТОГРАФИЯ

- Модификация спектров отражения пленок диазохинон-новолачного фоторезиста при имплантации ионами бора и фосфора
Д. И. Бринкевич, А. А. Харченко, В. С. Просолович, В. Б. Оджаев, С. Д. Бринкевич, Ю. Н. Янковский 235
-
- Вниманию авторов 240
-
-